

20、MOSFET 型号命名规则
AP200N04TLG5

AP		200	N	04			TL	G5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
序号	解析	编码	解析					
1	简称	AP	永源微电子					
2	工艺制程	留空	沟槽 (Trench)					
		C	潮解多层外延工艺 (Multi-EPI)					
		K	平面工艺 (Planar)					
		G	屏蔽删 (SGT)					
		J	超结深沟槽工艺 (Super Junction)					
		D	耗尽型工艺 (Depletion)					
		H	工业级 MOSFET					
3	额定电流		数字前加“0”表示小数点					
4	沟道	N	N 沟道					
		P	P 沟道					
		H	N+N 沟道					
		V	P+P 沟道					
		G	N+P 沟道					
5	额定电压		实际耐压等于: 数值*10					
6	版本号	A/B/C/D/E	版本号					
7	特殊开启电压	L	30-300V 产品 Vth 1V 以内					
		H	30-300V 产品 Vth 2.5V 以上					
8	表示封装形式	I	SOT23L	ES	ESOP-8			
		MI	SOT23-3L	T6	TO263-6L			
		LI	SOT23-6L	MP	TO247-3L			
		SI	SOT89-3L	VP	TO264-3L			
		MSI	SOT223-3L	TS	TSSOP-8L			
		D	TO252-3L	BF	QFN2*2-6L			
		Y	TO251-3L	CF	DFN2*3-6L			
		GD	TO252-4L	DF	PDFN3*3-8L			
		F	TO220F-3L	NF	PDFN5*6-8L			
		P	TO220-3L	NF2	PDFN5*6-8L 上下架构			
		T	TO263-3L	TL	TOLLA-8L			
		T2	TO262-3L	SL	STOLL-6L			
		S	SOP-8L	DW	SOT363-6L			
		L	SOT323-3L					
		9	工艺等级	G5	SGT 第五代			